

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 3 区分

【発行日】平成 17 年 10 月 20 日 (2005.10.20)

【公開番号】特開 2003-94400 (P2003-94400A)

【公開日】平成 15 年 4 月 3 日 (2003.4.3)

【出願番号】特願 2002-195692 (P2002-195692)

【国際特許分類第 7 版】

B 8 2 B 3/00

G 1 1 B 9/10

【F I】

B 8 2 B 3/00 Z N M

G 1 1 B 9/10 A

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 7 月 1 日 (2005.7.1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

電子源としてナノチューブのアレイを含む、データ記憶デバイス。

【請求項 2】

前記ナノチューブがカーボンをベースにしている、請求項 1 に記載のデバイス。

【請求項 3】

前記ナノチューブが窒化ホウ素をベースにしている、請求項 1 に記載のデバイス。

【請求項 4】

前記電子源の先端部に隣接する相変化記憶層をさらに含む、請求項 1 に記載のデバイス

。

【請求項 5】

各ナノチューブ電子源が伸長される、請求項 1 に記載のデバイス。

【請求項 6】

前記ナノチューブが 10 : 1 より大きいアスペクト比を有する、請求項 5 に記載のデバイス。

【請求項 7】

前記ナノチューブをアドレス指定するためのワード線およびビット線をさらに含む、請求項 1 に記載のデバイス。

【請求項 8】

前記アレイを位置決めするためのマイクロムーバをさらに含む、請求項 1 に記載のデバイス。

【請求項 9】

カーボンベースのナノチューブのアレイと、及び

前記ナノチューブの先端部に隣接する相変化記憶層とを含む、データ記憶デバイス。

【請求項 10】

窒化ホウ素ベースのナノチューブのアレイと、及び

前記ナノチューブの先端部に隣接する相変化記憶層とを含む、データ記憶デバイス。

【請求項 11】

ナノチューブのアレイを含む、データ記憶デバイス用の電子ビーム源。

【請求項 1 2】

前記ナノチューブがカーボンナノチューブである、請求項 1 1 に記載の電子ビーム源。

【請求項 1 3】

前記ナノチューブが窒化ホウ素ナノチューブである、請求項 1 1 に記載の電子ビーム源。

【請求項 1 4】

前記ナノチューブが 1 0 : 1 より大きいアスペクト比を有する、請求項 1 1 に記載の電子ビーム源。

【請求項 1 5】

前記ナノチューブをアドレス指定するためのワード線およびビット線をさらに含む、請求項 1 1 に記載の電子ビーム源。

【請求項 1 6】

前記アレイを位置決めするためのマイクロムーバをさらに含む、請求項 1 1 に記載の電子ビーム源。